

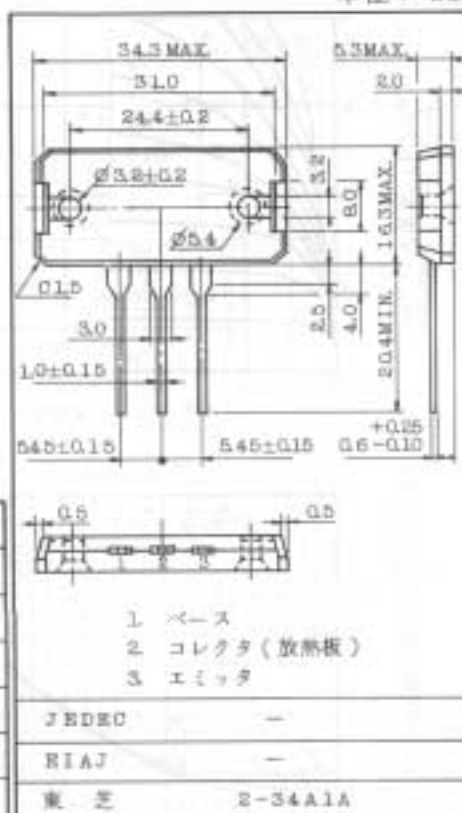
2SA1094 シリコンPNPエビタキシャル形トランジスタ(PCT方式)

○ 電力増幅用

特長

- ・ 高耐圧です。: $V_{CE0} = -140V$
- ・ トランジション周波数が高い。: $f_T = 70MHz$ (標準)
- ・ 2SC2564とコンプリメンタリになります。
- ・ 80W ハイファイオーディオアンプに最適です。

単位: mm



最大定格 ($T_a = 25^\circ C$)

項目	記号	定格	単位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CE0}	-140	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CE0}	-140	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EB0}	-5	V
コレクタ電流	I_C	-12	A
ベース電流	I_B	-12	A
コレクタ損失 ($T_c = 25^\circ C$)	P_C	120	W
接合温度	T_j	150	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ 150	$^\circ C$

電気的特性 ($T_a = 25^\circ C$)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
コレクタし+断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -140V, I_E = 0$	-	-	-50	μA
エミッタし+断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -5V, I_C = 0$	-	-	-50	μA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = -0.1A, I_B = 0$	-140	-	-	V
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E = -0.01A, I_C = 0$	-5	-	-	V
直流電流増幅率	$h_{FE(1)}$ (往)	$V_{CE} = -5V, I_C = -1A$	55	-	240	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE} = -5V, I_C = -5A$	30	-	-	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -5A, I_E = -0.5A$	-	-	-2.0	V
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	$V_{CE} = -5V, I_C = -5A$	-	-	-2.0	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE} = -10V, I_C = -1A$	-	70	-	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = -10V, I_E = 0, f = 1MHz$	-	220	-	pF

注: $h_{FE(1)}$ 分類 R: 55~110, O: 80~160, Y: 120~240